

01;12

Нестационарные движения электронов двойного плазменного слоя в самосогласованном электрическом поле пространственного заряда

© В.А. Федоров

Открытое акционерное общество
„Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца“,
125083 Москва, Россия
e-mail: f_v99@mail.ru

(Поступило в Редакцию 15 декабря 2004 г.)

Исследованы нестационарные одномерные движения электронов двойного плазменного слоя под действием самосогласованного электрического поля пространственного заряда и силы трения. Получены аналитические решения нелинейной системы уравнений гидродинамики плазмы для электронов. Найдены изменения напряженности электрического поля, скорости и концентрации электронов в зависимости от времени и расстояния. Определены динамические характеристики некоторых видов движений электронов плазмы, имеющих различный тип симметрии.

1. Исследования динамики потоков заряженных частиц представляют большой интерес в связи с теоретическими и техническими приложениями, возникающими при построении теории различных радиофизических устройств, при формировании, инжекции и транспортировке пучков электронов или ионов в плазме и в вакууме и т.д. [1,2]. Часто эти исследования проводят применительно к двойным плазменным слоям, которые являются фундаментальными структурами плазмы и встречаются как в лабораторных условиях (плазмозаполненные приборы, плазменные зонды), так и в космосе (зоны полярных сияний, активные эксперименты с инжекцией заряженных частиц в ионосфере) [3,4]. Как правило, настоящие структуры состоят из двух частично разделенных в пространстве слоев электрических зарядов разного знака, имеющих неодинаковую концентрацию частиц. Это приводит к тому, что плазма становится заряженной, а потоки заряженных частиц не скомпенсированными по объемному заряду. Причем обычно двойные плазменные слои изучают либо в стационарном состоянии, когда заданы граничные условия, а ищут токи заряженных частиц [5], либо в равновесии, когда задают распределение электрического потенциала, а определяют поведение системы, условия ее устойчивости и т.д. [6].

В данной работе изучаются одномерные движения электронов двойного плазменного слоя, в котором к моменту времени $t = 0$ электроны и ионы полностью разделены в пространстве и имеют общую границу, а их суммарный электрический заряд равен нулю. При этом ионы считаются покоящимися для $t \geq 0$. Решение задачи будет проводиться на интервале времени $0 \leq t \leq t_r$, где t_r — момент времени, когда скорость электронов в какой-нибудь точке пространства становится равной нулю или когда фронт потока электронов достигает границы слоя. Первое ограничение связано с тем, что при $t > t_r$ могут возникнуть обратные токи электронов, а следовательно, пересечение траекторий частиц, что сделает применение гидродинамики несправедливым. Второе ограничение говорит о том, что движение

электронов должно происходить в пределах объема, занимаемого двойным плазменным слоем. Если $t > t_r$, то при достижении фронтом потока электронов границы слоя необходимо исключать из рассмотрения электроны, которые покидают его объем и перестают вносить вклад в напряженность электрического поля, возникающего в слое. Это обстоятельство не позволяет получить аналитические решения задачи.

Рассмотрим двойной плазменный слой объемом $V = V_e + V_i$, где V_e, V_i — объемы, занимаемые электронами и ионами в момент времени $t = 0$, которые ограничены координатами $0 \leq R < \Delta$ и $\Delta \leq R \leq R_c$. Таким образом, $0, R_c$ и Δ есть расстояния от начала координат левой и правой границ двойного плазменного слоя и границы между V_e и V_i соответственно. Следовательно, электроны в процессе движения могут располагаться на отрезке $0 \leq R \leq R_c$, а ионы находятся в покое на отрезке $\Delta \leq R \leq R_c$. Пусть величины зарядов электронов Q_e и ионов Q_i в объемах V_e и V_i таковы, что

$$Q_e + Q_i = 0. \quad (1)$$

Здесь Q_e, Q_i — непрерывные функции в V_e, V_i :

$$Q_e = \int_{V_e} en_e dV_e, \quad Q_i = \int_{V_i} |e|n_i dV_i; \quad (2)$$

e — заряд электрона; n_e, n_i — концентрация электронов и ионов плазмы.

Принимая во внимание одномерность движения и выражения (2), равенство (1) представим в виде

$$\int_0^{\Delta} en_e(R, 0)R^k dR - \int_{\Delta}^{R_c} en_i(R, 0)R^k dR = 0, \quad (3)$$

где $k = 0, 1, 2$ для случаев плоской, цилиндрической и сферической симметрии соответственно.

2. Для исследования динамики электронов с учетом сделанных выше приближений, воспользуемся системой уравнений одножидкостной гидродинамики холодной плазмы с силой трения, которая пропорциональна скорости движения [7]. Пренебрегая тепловыми эффектами, данную систему в одномерном случае запишем в виде

$$\frac{\partial V_e}{\partial t} + V_e \frac{\partial V_e}{\partial R} + v_e V_e = \frac{e}{m_e} E, \quad (4)$$

$$\frac{1}{R^k} \frac{\partial}{\partial R} (R^k E) = 4\pi e(n_e - n_i), \quad (5)$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} = -4\pi e n_e V_e. \quad (6)$$

Здесь $E(R, t) = E_e(R, t) + E_i(R, 0)$ — напряженность электрического поля, создаваемого электронами и ионами; $V_e(R, t)$ — скорость электронов; R — радиус точки пространства; m_e — масса электрона; $v_e = \text{const}$ — частота столкновений электронов с нейтральными частицами.

Чтобы система уравнений (4)–(6) стала замкнутой, дополним ее начальными и граничными условиями [8]. В качестве начальных условий для $t = 0$ зададим

$$V_{e,i}(R_*, 0) = 0, \quad n_{e,i}(R_*, 0) = n_{e,i}^0 f_{e,i}(R_*, 0), \quad (7)$$

$$E(R_*, 0) = \frac{4\pi}{R_*^k} \int_0^{R_*} [en_e^0 f_e(R_*, 0) - \chi en_i^0 f_i(R_*, 0)] R_*^k dR_*, \quad (8)$$

где $0 \leq R_* \leq R_c$; $n_e^0 = n_i^0 = \text{const}$ — невозмущенные концентрации электронов и ионов плазмы; $f_{e,i}(R, 0) \geq 1$ — функции, задающие $n_{e,i}(R, 0)$; $\chi = 0$, если $0 \leq R < \Delta$, и $\chi = 1$, если $\Delta \leq R \leq R_c$.

Граничные условия на внешних границах V_e, V_i , которые неподвижны, имеют вид

$$V_e(0, t) = 0, \quad n_e(0, t) = n_e^0 f_e(0, 0),$$

$$V_i(R_c, t) = 0, \quad n_i(R_c, t) = n_i^0 f_i(R_c, 0), \quad (9)$$

$$E(0, t) = 0, \quad E(R_c, t) = 0. \quad (10)$$

Граничные условия для электронов на подвижной границе V_e и ее положение в пространстве определяются из решения системы уравнений (4)–(6).

Интегрируя (5) по объему V в пределах от 0 до R , где координатой R обозначено конечное положение подвижной границы объема V_e , имеющей при $t = 0$ координату R_* , с использованием теоремы Гаусса получим

$$E(R, t) = \frac{m_e}{e} \frac{\omega_0^2}{P(k)n_e^0} [\Psi_e(R, t) - \chi \Psi_i(R, 0)] \frac{1}{R^k}. \quad (11)$$

Здесь $\omega_0^2 = 4\pi e^2 n_e^0 / m_e$, $P(k) = 1, 2\pi, 4\pi$ для плоской, цилиндрической и сферической симметрии; $\Psi_e(R, t) = \int_0^R n_e(R, t) R^k dR$, $\Psi_i(R, t) = \chi P(k) \int_{\Delta}^R n_i(R, 0) R^k dR$ — функции массовой переменной Лагранжа [9], которые в

данном случае определяют число электронов и ионов, а также величины их зарядов $q_e = e\Psi_e$, $q_i = |e|\Psi_i$ в объемах $V_e(0, R)$ и $V_i(\Delta, R)$.

Положим, что траектории различных элементов объемов не пересекаются, тогда число электронов в объеме V_e , задаваемом координатами $[0, R_*(0)]$ и $[0, R(t)]$, где $R_*(0), R(t)$ — начальное и конечное положения подвижной границы объема, не меняется с течением времени, поэтому можно написать следующее равенство [9]:

$$\int_0^R n_e(R, t) R^k dR = \int_0^{R_*} n_e(R_*, 0) R_*^k dR_*. \quad (12)$$

Таким образом, учитывая (12), выражение (11) представим в виде

$$E(R_*, R) = \frac{m_e}{e} \left[C(R_*) - \chi \omega_0^2 \int_{\Delta}^R f_i(R_*, 0) R_*^k dR_* \right] \frac{1}{R^k}, \quad (13)$$

$$\text{где } C(R_*) = \omega_0^2 \int_0^{R_*} f_e(R_*, 0) R_*^k dR_*.$$

Подставляя (13) в уравнение (4), имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_e}{\partial t} + V_e \frac{\partial V_e}{\partial R} + v_e V_e \\ = \left[C(R_*) - \chi \omega_0^2 \int_{\Delta}^R f_i(R_*, 0) R_*^k dR_* \right] \frac{1}{R^k}. \end{aligned} \quad (14)$$

Переходя к субстанциональной производной в (14), найдем

$$\frac{d^2 R}{dt^2} + v_e \frac{dR}{dt} = \left[C(R_*) - \chi \omega_0^2 \int_{\Delta}^R f_i(R_*, 0) R_*^k dR_* \right] \frac{1}{R^k}. \quad (15)$$

Записывая (5) в переменных Лагранжа, получим уравнение для определения $n_e(R_*, t)$

$$\begin{aligned} n_e(R_*, t) = \chi n_i(R_*, 0) \\ + \frac{1}{4\pi e} \left(k \frac{E}{R} + \frac{\partial E}{\partial R} + \frac{\partial E}{\partial R_*} \frac{1}{\partial R / \partial R_*} \right). \end{aligned} \quad (16)$$

3. Пусть $k = 0$, $n_i(R_*, 0) = n_i^0$, т.е. $f_i(R_*, 0) = 1$. В данном случае движение электронов с плоской симметрией происходит при $R < \Delta$ на фоне нейтральных частиц, а при $\Delta \leq R \leq R_c$ — на фоне нейтральных частиц и однородном фоне ионов плазмы.

а) Если $R < \Delta$, то решения системы уравнений (4)–(6), исходя из (13)–(16), даются выражениями

$$E(R_*) = \frac{m_e}{e} C(R_*), \quad (17)$$

$$R(R_*, t) = R_* + \frac{C(R_*)}{v_e^2} [v_e t - 1 + \exp(-v_e t)], \quad (18)$$

$$V_e(R_*, t) = \frac{C(R_*)}{v_e} [1 - \exp(-v_e t)], \quad (19)$$

$$n_e(R_*, t) = \frac{n_e^0 f_e(R_*, 0)}{1 + \frac{\omega_0^2}{v_e^2} \{v_e t - [1 - \exp(-v_e t)]\} f_e(R_*, 0)}. \quad (20)$$

Отметим, что в выражениях (17)–(20) содержатся значения констант интегрирования, которые были найдены с учетом начальных условий.

Из рассмотрения (17)–(20) видно, что $E(R_*) = \text{const}|_R$ в силу плоской симметрии и начальных условий и $E(R_*) = \text{const}|_t$ в силу того, что $\partial q_e / \partial t = 0$, где q_e — заряд электронов в объеме, ограниченном координатами $0 \leq R \leq R_*$ (см. (12)). При этом $E(R_*)$ соответствует напряженности заряженной бесконечной проводящей плоскости. Пусть для частиц, движущихся на отрезке $0 < R < \Delta$, выполнено $v_e t \gg 1$, тогда $R(R_*, t) \approx R_* + [C(R_*)/v_e]t$, $V_e(R_*, t) \rightarrow C(R_*)/v_e = \text{const}|_t$, $n_e(R_*, t) \approx n_e^0 v_e / \omega_0^2 t$, а время их движения на данном отрезке оценим, используя выражение (18), где примем $R(R_*, t) \leq \Delta$. Таким образом, имеем

$$t(R_*, \Delta) \leq \frac{v_e R_*}{C(R_*)} \left(\frac{\Delta}{R_*} - 1 \right). \quad (21)$$

Положив $f_e(R_*, 0) = \mu = \text{const}$ (равномерное распределение $n_e(R_*, 0)$), из (21) получим

$$t(R_*, \Delta) \leq \frac{v_e}{\mu \omega_0^2} \left(\frac{\Delta}{R_*} - 1 \right). \quad (22)$$

В случае $v_e \rightarrow 0$ выражения (17)–(20) переходят в решения системы уравнений (4)–(6), определяющие движение электронов в вакууме [10].

б) Если $\Delta \leq R \leq R_c$ и $v_e < 2\omega_0$ (слабое сопротивление), то, учитывая (13)–(16), получим решения системы уравнений (4)–(6), которые имеют вид

$$E(R_*, t) = -\frac{m_e}{e} \omega_0^2 \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) (G_1 \sin \Omega t + G_2 \cos \Omega t), \quad (23)$$

$$R(R_*, t) = \Delta + \frac{C(R_*)}{\omega_0^2} + \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) (G_1 \sin \Omega t + G_2 \cos \Omega t), \quad (24)$$

$$V_e(R_*, t) = \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) (G_3 \sin \Omega t + G_4 \cos \Omega t), \quad (25)$$

$$n_e(R_*, t) = \frac{n_e^0 f_e(R_*, 0)}{f_e(R_*, 0) + \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) (G'_1 \sin \Omega t + G'_2 \cos \Omega t)}. \quad (26)$$

Здесь $\Omega = (4\pi e^2 n_0^0 / m_e - v_e^2 / 4)^{1/2} = (\omega_0^2 - v_e^2 / 4)^{1/2}$, а G_1, G_2, G_3, G_4 являются функциями от R_* . Штрих в (26) означает дифференцирование по R_* . Из выражений (23)–(26) видно, что в случае $v_e t \gg 1$ колебания электронов затухают, а именно $E(R_*, t) \rightarrow 0$,

$R(R_*, t) \rightarrow \Delta + C(R_*)/\omega_0^2$, $V_e(R_*, t) \rightarrow 0$, $n_e(R_*, t) \rightarrow n_e^0$, т. е. частицы стремятся к состоянию покоя. При этом они не должны покидать объем плазменного слоя, что выполняется, если $R(R_*, t) \rightarrow \Delta + C(R_*)/\omega_0^2 \leq R_c$. Полагая $f_e(R_*, 0) = \mu$, имеем $R(R_*, t) \rightarrow \Delta + \mu R_* \leq R_c$. Отсюда получим, что $\mu \leq (R_c - \Delta)/R_*$, а принимая $R_* = \Delta$ (начальная координата фронта потока электронов), найдем максимальное значение $n_e(R_*, 0) = n_e^0 \mu = n_e^0 (R_c / \Delta - 1)$, для которого частицы на фронте потока не выйдут за R_c , т. е. $R(R_*, t) \leq R_c$. Заметим, что определение констант G_1, G_2, G_3, G_4 связано с необходимостью использования выражений (17)–(20), задающих „начальные условия“ решениям (23)–(26) в точке $R(R_*, t) = \Delta$. Чтобы в явном виде выразить G_1, G_2, G_3, G_4 при движении частиц в области $\Delta \leq R \leq R_c$, нужно каждой частице с координатой R_* из области $0 < R < \Delta$ найти соответствующие $t(R_*, \Delta)$ и $V_e(R_*, \Delta)$. Однако в общем случае сделать это невозможно, так как приходится решать нелинейные уравнения. Поэтому константы G_1, G_2, G_3, G_4 в (23)–(26) остались неопределенными.

в) Если $\Delta \leq R \leq R_c$ и $v_e > 2\omega_0$ (сильное сопротивление), то решения системы уравнений (2)–(4) с использованием (13)–(16) даются выражениями

$$E(R_*, t) = -\frac{m_e}{e} \omega_0^2 \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) \times [G_5 \exp(\xi t) + G_6 \exp(-\xi t)], \quad (27)$$

$$R(R_*, t) = \Delta + \frac{C(R_*)}{\omega_0^2} + \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) [G_5 \exp(\xi t) + G_6 \exp(-\xi t)], \quad (28)$$

$$V_e(R_*, t) = \xi \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) [G_7 \exp(\xi t) - G_8 \exp(-\xi t)], \quad (29)$$

$$n_e(R_*, t) = \frac{n_e^0 f_e(R_*, 0)}{f_e(R_*, 0) + \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) [G'_5 \exp(\xi t) + G'_6 \exp(-\xi t)]}, \quad (30)$$

где $\xi = (v_e^2 / 4 - \omega_0^2)^{1/2}$.

Выражения (27)–(30) определяют аperiodическое движение частиц, стремящихся к своим положениям покоя, не испытывая колебаний. Если $v_e t \gg 1$, $v_e^2 / \omega_0^2 \gg 1$, $R(R_*, t) \leq R_c$, то из (27)–(30) имеем

$$E(R_*, t) \approx -(m_e / e) \omega_0^2 G_5 \exp[-v_e t / (v_e^2 / \omega_0^2)],$$

$$R(R_*, t) \approx \Delta + C(R_*) / \omega_0^2 + G_5 \exp[-v_e t / (v_e^2 / \omega_0^2)],$$

$$V_e(R_*) \approx \xi G_7 \exp[-v_e t / (v_e^2 / \omega_0^2)],$$

$$n_e(R_*) \approx n_e^0 f_e(R_*, 0) / \{f_e(R_*, 0) + G'_5 \exp[-v_e t / (v_e^2 / \omega_0^2)]\}.$$

Отметим, что в решениях (27)–(30) константы G_5, G_6, G_7, G_8 не могут быть записаны в явном виде в общем случае.

Исследуем характер движения частиц на фронте электронного потока. Подставляя в формулы (27)–(30) выражения

$$\begin{aligned} C(\Delta) &= \omega_0^2 f_e(\Delta, 0)\Delta, \\ G_5 &= -(1 + v_e/2\xi)f_e(\Delta, 0)\Delta/2, \\ G_6 &= -(1 - v_e/2\xi)f_e(\Delta, 0)\Delta/2, \\ G_7 &= (1 - v_e/2\xi)G_5, \quad G_8 = (1 + v_e/2\xi)G_6, \\ G'_5 &= -(1 + v_e/2\xi)f_e(\Delta, 0)/2, \\ G'_6 &= -(1 - v_e/2\xi)f_e(\Delta, 0)/2, \end{aligned}$$

найденные для $R_* = \Delta$, $V_e(\Delta, 0) = 0$, получим

$$\begin{aligned} E(\Delta, t) &= \frac{f_e(\Delta, 0)\Delta}{2} \frac{m_e}{e} \omega_0^2 \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) \\ &\times \left[\left(1 + \frac{v_e}{2\xi}\right) \exp(\xi t) + \left(1 - \frac{v_e}{2\xi}\right) \exp(-\xi t) \right], \quad (31) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R(\Delta, t) &= \Delta + f_e(\Delta, 0)\Delta \left\{ 1 - \frac{1}{2} \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) \right. \\ &\times \left. \left[\left(1 + \frac{v_e}{2\xi}\right) \exp(\xi t) + \left(1 - \frac{v_e}{2\xi}\right) \exp(-\xi t) \right] \right\}, \quad (32) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_e(\Delta, t) &= -\frac{f_e(\Delta, 0)\Delta}{2} \left(1 - \frac{v_e^2}{4\xi^2}\right) \xi \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) \\ &\times [\exp(\xi t) - \exp(-\xi t)], \quad (33) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n_e(\Delta, t) &= \frac{n_e^0}{1 - \frac{1}{2} \exp\left(-v_e \frac{t}{2}\right) \left[\left(1 + \frac{v_e}{2\xi}\right) \exp(\xi t) + \left(1 - \frac{v_e}{2\xi}\right) \exp(-\xi t) \right]}. \quad (34) \end{aligned}$$

Если $v_e t \gg 1$, $v_e^2/\omega_0^2 \gg 1$, то из (31)–(34) имеем

$$\begin{aligned} E(\Delta, t) &\approx (m_e/e)\omega_0^2 f_e(\Delta, 0)\Delta \exp[-v_e t/(v_e^2/\omega_0^2)], \\ R(\Delta, t) &\approx \Delta + f_e(\Delta, 0)\Delta \{1 - \exp[-v_e t/(v_e^2/\omega_0^2)]\}, \\ V_e(\Delta, t) &\approx [\omega_e^2 f_e(\Delta, 0)\Delta/v_e] \exp[-v_e t/(v_e^2/\omega_0^2)], \\ n_e(\Delta, t) &\approx n_e^0/\{1 - \exp[-v_e t/(v_e^2/\omega_0^2)]\}. \end{aligned}$$

Полагая в (32) $R(\Delta, t) = R_c$, найдем время достижения правой границы R_c фронтом потока электронов или время t_r (см. раздел 1)

$$t(\Delta, R_c) \approx -\frac{v_e}{\omega_0^2} \ln \left[\frac{1}{f_e(\Delta, 0)} \left(\frac{R_c}{\Delta} - 1 \right) \right] \equiv t_r. \quad (35)$$

Пусть в (35) имеем $(R_c/\Delta - 1)/f_e(\Delta, 0) \approx 1$, тогда $t_r \rightarrow \infty$. Отсюда следует, что в данном случае электроны не могут достичь границы R_c . Рассмотрение (33) показывает, что если $t \geq 0$, то $V_e(\Delta, t) \geq 0$, т.е. знак скорости частиц на фронте потока не меняется. Скорость принимает свое максимальное значение, когда

$$t(V_{e \max}(\Delta)) = \frac{1}{2\xi} \ln \left(\frac{1 + 2\frac{\xi}{v_e}}{1 - 2\frac{\xi}{v_e}} \right). \quad (36)$$

Если $v_e^2/\omega_0^2 \gg 1$ из (36) имеем $t(V_{e \max}(\Delta)) \approx (2/v_e) \ln(v_e/\omega_0)$. Для этого значения $t(V_{e \max}(\Delta))$ из выражения (33) найдем

$$V_{e \max}(\Delta) \approx f_e(\Delta, 0)\Delta \frac{\omega_0^2}{v_e}. \quad (37)$$

В случае $f_e(R_*, 0) = \mu$ из (35) и (37) получим $t(\Delta, R_c) \approx -(v_e/\omega_0^2) \ln[1 - (R_c - \Delta)/\mu\Delta]$ и $V_{e \max}(\Delta) \approx \mu\Delta\omega_0^2/v_e$ соответственно.

4. Уравнение (14) можно привести к уравнению Абеля второго рода [11]

$$V_e \frac{\partial V_e}{\partial R} + v_e V_e = \left[C(R_*) - \chi\omega_0^2 \int_{\Delta}^R f_i(R_*, 0)R_*^k dR_* \right] \frac{1}{R^k}. \quad (38)$$

Если $v_e = 0$, то решение уравнения (38) запишем следующим образом:

$$V_e(R_*, R) = \sqrt{2 \int_{R_*}^R \left[C(R_*) - \chi\omega_0^2 \int_{\Delta}^R f_i(R_*, 0)R_*^k dR_* \right] \frac{dR}{R^k}}. \quad (39)$$

Учитывая, что $V_e = dR/dt$, где R — зависящая от времени координата фиксированной частицы среды, из (39) получим

$$t(R_*, R) = \pm \int_{R_*}^R \frac{dR}{\sqrt{2 \int_{R_*}^R \left[C(R_*) - \chi\omega_0^2 \int_{\Delta}^R f_i(R_*, 0)R_*^k dR_* \right] \frac{dR}{R^k}}}. \quad (40)$$

Записывая уравнение (5) в переменных Лагранжа и используя выражения (13), (40), определим $n_e(R_*, R)$

$$n_e(R_*, R) = \chi n_i^0 + \frac{1}{4\pi e} \left(k \frac{E}{R} + \frac{\partial E}{\partial R} - \frac{\partial E}{\partial R_*} \frac{\partial t}{\partial R_*} \right). \quad (41)$$

Положим, например, $k = 2$ (варианты $k = 0, 1$ могут быть рассмотрены аналогичным образом). Пусть $n_i(R_*, 0) = n_i^0$, т.е. $f_i(R_*, 0) = 1$. В данном случае движение электронов со сферической симметрией происходит при $R < \Delta$ в вакууме, а при $\Delta \leq R \leq R_c$ — на однородном фоне ионов плазмы.

а) Если $R < \Delta$, то решения системы (4)–(6), исходя из (13), (39)–(41), имеют вид

$$E(R_*, R) = \frac{m_e}{e} \frac{C(R_*)}{R^2}, \quad (42)$$

$$V_e(R_*, R) = \sqrt{\frac{2C(R_*)}{R_*} \left(1 - \frac{R_*}{R} \right)}, \quad (43)$$

$$t(R_*, R) = \sqrt{\frac{R_*^3}{2C(R_*)}} \left(\frac{R}{R_*} \sqrt{1 - \frac{R_*}{R}} - \text{Arth} \sqrt{1 - \frac{R_*}{R}} \right), \quad (44)$$

$$n_e(R_*, R) = n_e^0 \frac{R^3}{R^3} \times \frac{f_e(R_*, 0)}{1 - \frac{3}{2} \left[1 - \frac{\omega_0^2 f_e(R_*, 0) R_*^3}{3C(R_*)} \right] \left(1 - \frac{R_*}{R} \sqrt{\frac{R}{R-R_*}} \operatorname{Arth} \sqrt{1 - \frac{R_*}{R}} \right)}. \quad (45)$$

Из рассмотрения (42) видно, что $E(R_*, R) \sim 1/R^2$ в силу того, что имеет место сферическая симметрия электронного потока. Так как в выражении (43) $V_e(R_*, R) > 0$, поэтому движение электронов происходит без пересечения траекторий частиц. При $R_*/R \ll 1$ из (43), (44) имеем $V_e(R_*) \approx \sqrt{2C(R_*)/R_*} = \operatorname{const}|_R$, $t(R_*, R) \approx (R/R_*) \sqrt{R_*^3/2C(R_*)}$ соответственно, т.е. скорость движения не зависит от расстояния, а время растет с расстоянием линейно. Если $f_e(R_*, 0) = \mu$, то $V_e(R_*) \sim R_*$. Отсюда следует, что в случае задания равномерного распределения $n_e(R_*, R)$ частицы не обгоняют друг друга. Положив в (43) $R = \Delta$, получим формулу, определяющую величину скорости, с которой частица с начальной координатой R_* попадает на слой ионов плазмы или отрезок $(R_c - \Delta)$

$$V_e(R_*, \Delta) = \sqrt{\frac{2C(R_*)}{R_*} \left(1 - \frac{R_*}{\Delta} \right)}. \quad (46)$$

Выражение (46) является „начальным условием“ при определении величины $V_e(R_*, R)$ для частиц, которые начинают движение на фоне ионов. Рассмотрение (45) показывает, что в данном случае концентрация электронов при движении в вакууме падает как $n_e(R_*, R) \sim 1/R^3$.

б) Если $\Delta \leq R \leq R_c$, то решения системы (2)–(4), исходя из (13), (39)–(40), запишем следующим образом:

$$E(R_*, R) = \frac{m_e}{e} \frac{\omega_0^2}{3} \left\{ \left[1 + \frac{3C(R_*)}{\omega_0^2 \Delta^3} \right] \frac{\Delta^3}{R^2} - R \right\}, \quad (47)$$

$$V_e(R_*, R) = \omega_0 R_*$$

$$\times \sqrt{\frac{2}{3} \left[\frac{3C(R_*)}{\omega_0^2 R_*^3} + \frac{\Delta^3}{R_*^3} \right] \left(1 - \frac{R_*}{R} \right) + \frac{1}{3} \left(1 - \frac{R^2}{R_*^2} \right)}, \quad (48)$$

$$t(R_*, R) = \pm \frac{1}{\omega_0 R_*}$$

$$\times \int_{R_*}^R \frac{dR}{\sqrt{\frac{2}{3} \left[\frac{3C(R_*)}{\omega_0^2 R_*^3} + \frac{\Delta^3}{R_*^3} \right] \left(1 - \frac{R_*}{R} \right) + \frac{1}{3} \left(1 - \frac{R^2}{R_*^2} \right)}}. \quad (49)$$

Интеграл в выражении (49) можно привести к эллиптическому интегралу 3-го рода [12], который не представим в виде элементарных функций (при значениях $k = 0, 1$ данное замечание снимается). Чтобы получить аналитическое выражение $t(R_*, R)$, рассмотрим интеграл в (49) в двух случаях: $R_*/R \approx 1$ и $R_*/R \ll 1$. Пусть $R_*/R \approx 1$, тогда $R/R_* \approx 1$, $R_*/\Delta \approx 1$. Таким образом, из (49) найдем

$$t(R_*, R) \approx \frac{1}{\omega_0} \sqrt{\frac{\omega_0^2 R_*^3}{2C(R_*)} \left(\frac{R}{R_*} - 1 \right)}. \quad (50)$$

Если $R_*/R \ll 1$, то $R/R_* \gg 1$, поэтому из (49) найдем

$$t(R_*, R) \approx \frac{\sqrt{3}}{\omega_0} \operatorname{arcSin} \left\{ \frac{\frac{R}{R_*}}{\sqrt{2 \left[\frac{3C(R_*)}{\omega_0^2 R_*^3} + \frac{\Delta^3}{R_*^3} \right]}} \right\}, \quad (51)$$

где было учтено, что $\sqrt{2[3C(R_*)/\omega_0^2 R_*^3 + \Delta^3/R_*^3]} \gg 1$.

Полагая в (51) $R_* = \Delta$, а $R = R_c$, получим время движения фронта электронов до границы R_c (ср. (35))

$$t(\Delta, R_c) \approx \frac{\sqrt{3}}{\omega_0} \operatorname{arcSin} \left\{ \frac{\frac{R_c}{\Delta}}{\sqrt{2[f_e(\Delta, 0) + 1]}} \right\} \equiv t_r. \quad (52)$$

В дальнейшем электроны фронта покидают объем слоя, но движения вне слоя не рассматриваются. Заметим, что если $f_e(R_*, 0) = 1$, $R_c/\Delta = 2$, то $t_r \equiv \pi\sqrt{3}/2\omega_0$.

Для определения $n_e(R_*, R)$ примем сначала $R_*/R \approx 1$, тогда $t(R_*, R)$ выражается формулой (50). Подставляя (47) и (50) в (41), имеем

$$n_e(R_*, R) \approx n_e^0 f_e(R_*, 0). \quad (53)$$

Данный результат объясняется тем, что условие $R_*/R \approx 1$ относится к частицам, начальное местоположение которых близко к координате Δ , т.е. $R_*/\Delta \approx 1$. При этом время для них $t(R_*, R) \approx 0$ (см. (50)). Фактически же настоящие приближения применимы лишь к частице на фронте электронного потока, имеющей координату $R_* = \Delta$ и начинающей движение на отрезке $(R_c - \Delta)$. Поэтому $n_e(R_*, R)$ соответствует начальному распределению. Если $R_*/R \ll 1$, то $t(R_*, R)$ выражается формулой (51). Подставляя (47) и (51) в (41), получим

$$n_e(R_*, R) = n_e^0 \frac{R_*^3}{R^3} \frac{2}{3} \left[\frac{3C(R_*)}{\omega_0^2 R_*^3} + \frac{\Delta^3}{R_*^3} - 1 \right]. \quad (54)$$

Чтобы рассмотреть динамику электронов двойного плазменного слоя в случае конкретного начального распределения электронов, положим в формулах (42)–(45), а также в формулах (47), (48), (50), (51), (53), (54), например, $f_e(R_*, 0) = \mu$.

Если $R < \Delta$, то решения системы (4)–(6), исходя из (42)–(45), имеют вид

$$E(R_*, R) = \mu \frac{m_e}{e} \frac{\omega_0^2}{3} \frac{R_*^3}{R^2}, \quad (55)$$

$$V_e(R_*, R) = \omega_0 R_* \sqrt{\frac{2}{3} \mu \left(1 - \frac{R_*}{R} \right)}, \quad (56)$$

$$t(R_*, R) = \frac{1}{\omega_0} \sqrt{\frac{3}{2\mu}} \left(\frac{R}{R_*} \sqrt{1 - \frac{R_*}{R}} - \operatorname{Arth} \sqrt{1 - \frac{R_*}{R}} \right), \quad (57)$$

$$n_e(R_*, R) = \mu n_e^0 \frac{R_*^3}{R^3}. \quad (58)$$

Отметим, что формулы (55)–(58) были получены также в работе [10].

Если $\Delta \leq R \leq R_c$, то решения системы (2)–(4), исходя из (47), (48), (50), (51), (53), (54), запишем следующим образом:

$$E(R_*, R) = \frac{m_e \omega_0^2}{e} \frac{1}{3} \left[\left(1 + \mu \frac{R_*^3}{\Delta^3} \right) \frac{\Delta^3}{R^2} - R \right], \quad (59)$$

$$V_e(R_*, R) = \omega_0 R_* \sqrt{\frac{2}{3} \left(\mu + \frac{\Delta^3}{R_*^2} \right) \left(1 - \frac{R_*}{R} \right) + \frac{1}{3} \left(1 - \frac{R^2}{R_*^2} \right)}, \quad (60)$$

$$t(R_*, R) \approx \frac{1}{\omega_0} \sqrt{\frac{6}{\mu} \left(\frac{R}{R_*} - 1 \right)}, \quad R_*/R \approx 1, \quad (61)$$

$$n_e(R_*, R) \approx \mu n_e^0, \quad R_*/R \approx 1, \quad (62)$$

$$t(R_*, R) \approx \frac{\sqrt{3}}{\omega_0} \arcsin \left[\frac{\frac{R}{R_*}}{\sqrt{2 \left(\mu + \frac{\Delta^3}{R_*^2} \right)}} \right], \quad R_*/R \ll 1, \quad (63)$$

$$n_e(R_*, R) \approx n_e^0 \frac{R_*^3}{R^3} \frac{2}{3} \left(\mu + \frac{\Delta^3}{R_*^2} \right), \quad R_*/R \ll 1. \quad (64)$$

5. В заключение обсудим условия, в которых справедливы упрощающие предположения, принятые при постановке задачи.

а) Использование гидродинамического приближения холодной плазмы для электронов предполагает, что не учитываются тепловые скорости. Это возможно, когда направленная скорость электронов плазмы, приобретенная в электрическом поле, намного превышает их тепловые скорости, т.е.

$$\left| \frac{V_e(R_*, t), V_e(R_*, R)}{V_{eT}} \right| \gg 1, \quad (65)$$

где V_{eT} — тепловая скорость электронов плазмы.

Пусть $k = 0$. В этом случае для определения условий выполнения неравенства (65) можно воспользоваться формулами (19), (37), выражающими $V_e(R_*, t)$, в которых найдены константы интегрирования. Если выбрать, например, формулу (37) и подставить ее в (64), то получим условие, связывающее параметры среды n_e^0 , v_e , V_{eT} и геометрический фактор Δ , когда данное неравенство будет справедливо. Таким образом, из (65) имеем

$$\frac{\omega_0^2}{v_e} \frac{\Delta}{V_{eT}} \gg 1. \quad (66)$$

Аналогичные оценки можно сделать для значения $k = 2$.

б) При постановке задачи было пренебрежено движением ионов, т.е. считалось, что ионы обладают бесконечно большой массой ($m_i \rightarrow \infty$). Данное приближение ограничивает время рассмотрения процессов в системе и справедливо в случае, если имеет место неравенство

$$t \ll T_i \approx \frac{1}{\omega_{0i}}, \quad (67)$$

где $\omega_{0i}^2 = 4\pi e^2 n_i^0 / m_i$.

в) Применяемый метод решения не допускает, чтобы определяемые решениями траектории различных элементов объемов электронов пересекались, что может вызвать появление ударных волн, разрывы плотности среды и т.д. Условие непересекаемости траекторий различных элементов объемов электронов выполнено, если $\partial R / \partial R_* > 0$, тогда $n_e(R_*) / (\partial R / \partial R_*) > 0$. Если $n_e(R_*) = n_e^0$, то достаточным условием непересекаемости различных элементов объемов электронов является $|(dV_e(R_*, 0) / d(R_*)) / \omega_0| < 1$, т.е. распределение по R_* начальной скорости $V_e(R_*, 0)$ должно быть достаточно однородным [10].

Список литературы

- [1] Рухадзе А.А., Богданкевич Л.С., Росинский С.Е., Рухлин В.Г. Физика сильноточных релятивистских электронных пучков. М.: Атомиздат, 1980. 167 с.
- [2] Искусственные пучки частиц в космической плазме / Под ред. Б.М. Гранналя. М.: Мир, 1985. 456 с.
- [3] Eliezer S., Hora H. // Phys. Rep. 1989. Vol. 172. N 6 (whole issue). P. 339–407.
- [4] Block L.P. Phys. of Hot Plasma in the Magnetosphere / Ed. V. Hultquist, L. Stenflo. New York; London: Plenum Press, 1975. P. 229–250.
- [5] Langmuir I. // Phys. Rev. 1929. Vol. 33. P. 954–989.
- [6] Bernstein I.B., Green J.M., Kruskal M.D. // Phys. Rev. 1957. Vol. 108. P. 546–550.
- [7] Гинзбург В.Л., Рухадзе А.А. Волны в магнитоактивной плазме. М.: Наука, 1970. 208 с.
- [8] Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1. М.: Наука, 1983. 528 с.
- [9] Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной среды. М.: Наука, 1971. 854 с.
- [10] Федоров В.А. // РЭ. 2002. Т. 47. № 1. С. 103–109.
- [11] Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М.: Наука, 1976. 576 с.
- [12] Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.: Наука, 1971. 1108 с.